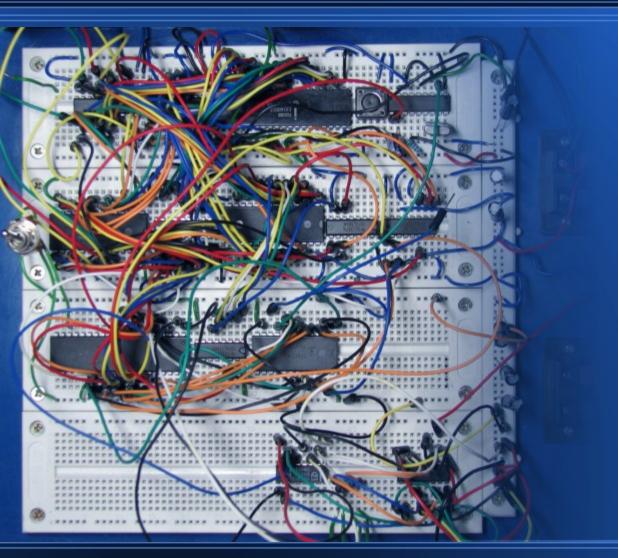
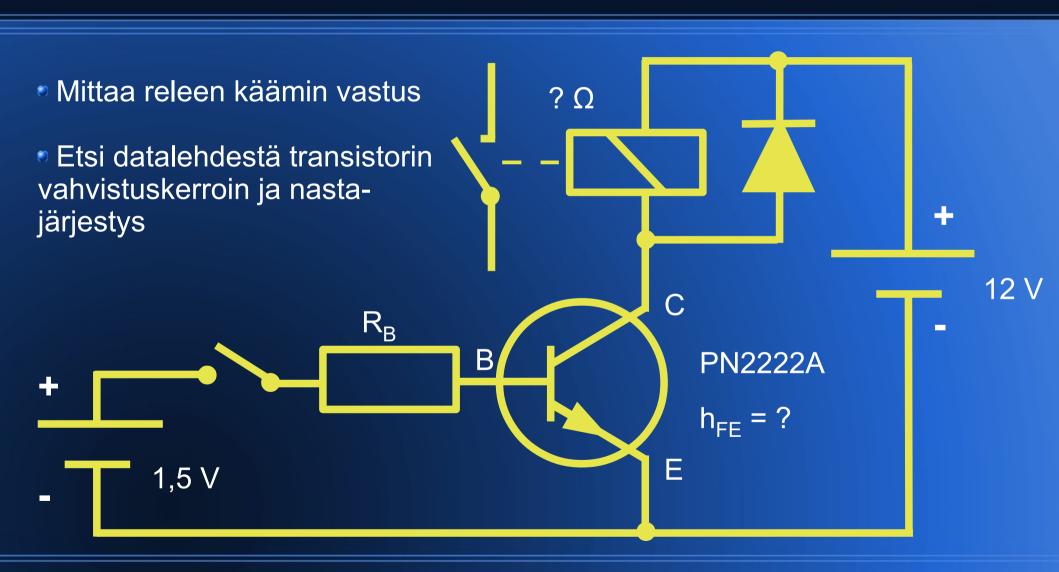
Epäteoreettisen elektroniikan perusteet

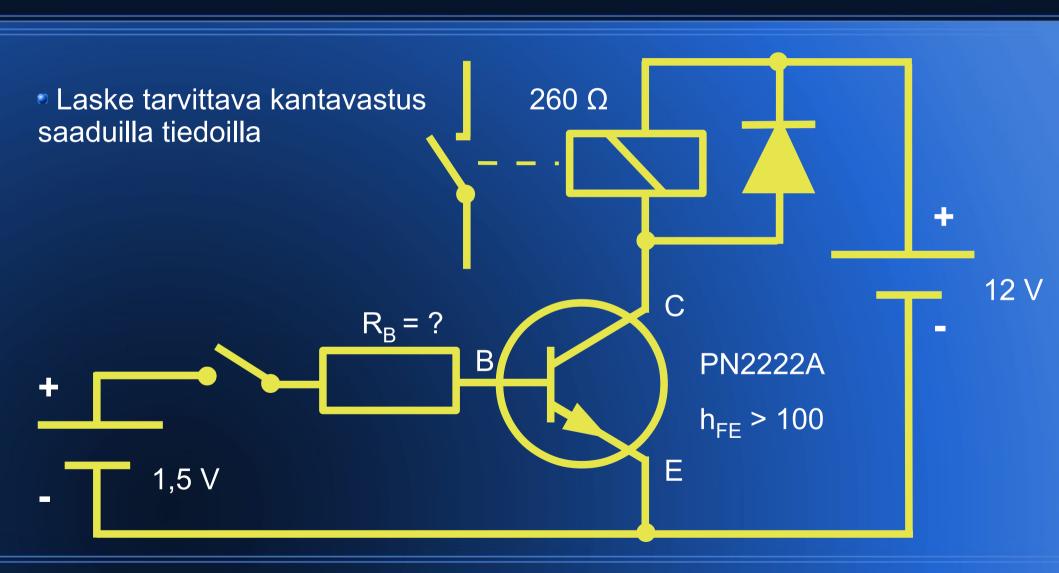


Labratyö 4: Releen ohjaaminen transistorilla

NPN-transistori kytkimenä



NPN-transistori kytkimenä



Kantavastuksen laskeminen

► Kollektorivirta, kun transistori johtaa (oletetaan U_{CE(sat)} ≈ 0)

$$I_{\rm C} = \frac{12 \text{ V}}{260 \Omega} = 46 \text{ mA}$$

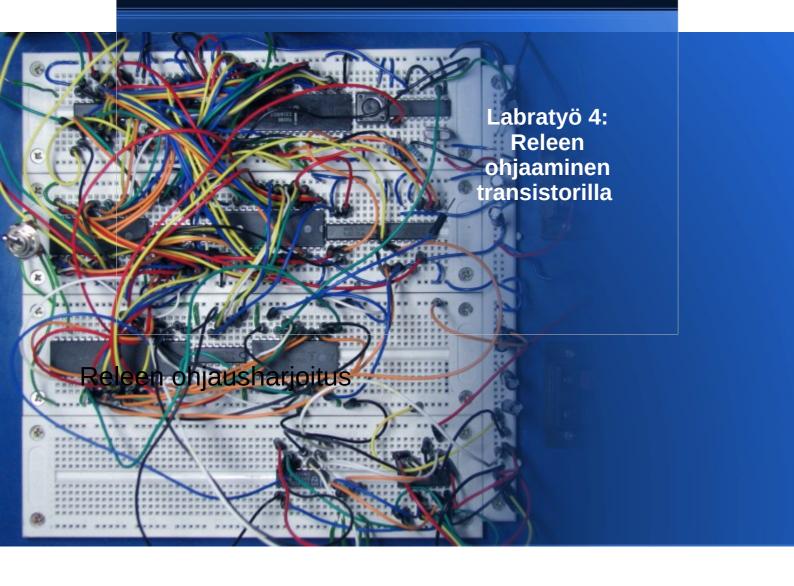
Tällöin kantavirran minimiarvo

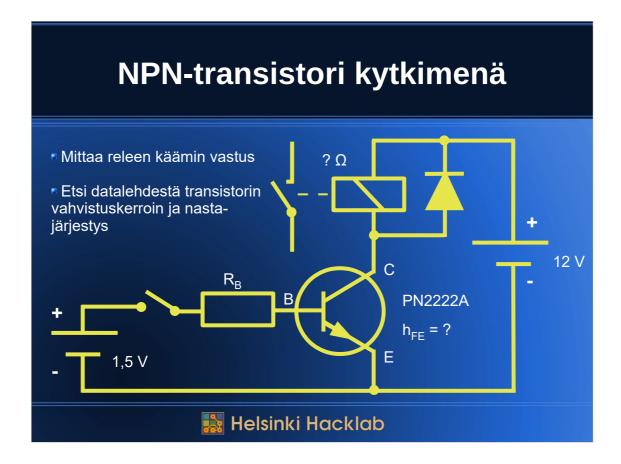
$$I_{B} = \frac{I_{C}}{h_{FF}} = \frac{46 \text{ mA}}{100} = 0,46 \text{ mA}$$

Jotta transistori kyllästyy kunnolla, valitaan kantavirta = 1,5 mA

• Joten R_B =
$$\frac{1,5V - U_{BE(on)}}{I_{B}} = \frac{1,5V - 0,7V}{1,5 \text{ mA}} = 533 \Omega ≈ 560 \Omega$$

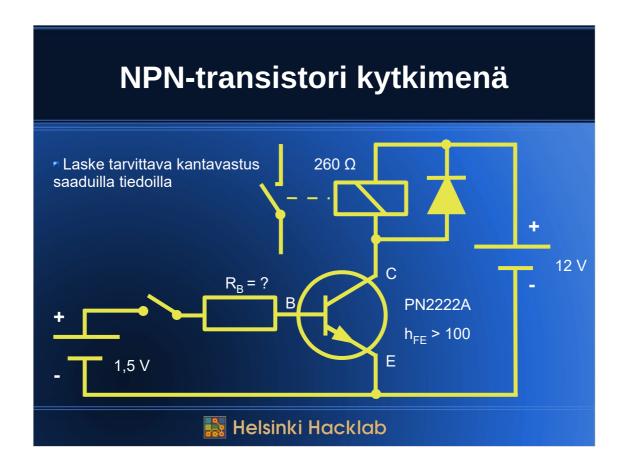
Epäteoreettisen elektroniikan perusteet





Käämin resistanssin voi mitata ohmimittarilla tavalliseen tapaan.

Vahvistuskerroin on datalehdessä annettu h_{FE}. Sille annetaan yleensä useita arvoja eri jännitteillä ja virroilla. "Vähintään 100" on yleensä hyvä arvaus pienille transistoreille, jos ei ole datalehteä käytettävissä.



Vastaukset perustietoihin, tästä voi lähetä laskemaan R_B:tä

Kantavastuksen laskeminen

Nollektorivirta, kun transistori johtaa (oletetaan U_{CE(sat)} ≈ 0)

$$I_C = \frac{12 \text{ V}}{260 \Omega} = 46 \text{ mA}$$

Tällöin kantavirran minimiarvo

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = \frac{46 \text{ mA}}{100} = 0,46 \text{ mA}$$

Jotta transistori kyllästyy kunnolla, valitaan kantavirta = 1,5 mA

• Joten R_B =
$$\frac{1,5V - U_{BE(on)}}{I_{B}} = \frac{1,5V - 0,7V}{1,5 \text{ mA}} = 533 \Omega ≈ 560 \Omega$$

Helsinki Hacklab

R_B:n mitoitus siten, että ollaan johtavassa tilassa kunnolla kyllästyksessä.